



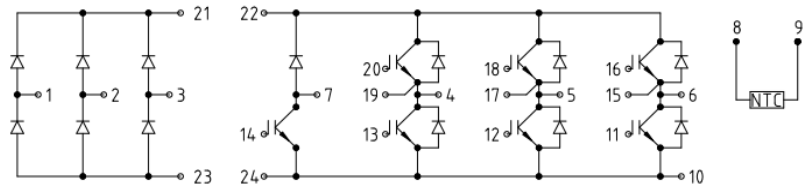
特征

- 采用最新沟槽栅场截止型IGBT芯片
- 采用外延扩铂FRD芯片
- 集成NTC温度传感器
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 100% RBSOA测试 ($2 \times I_C$)
- 低通态损耗 ($V_{CE}=2.0V$)
- 低关断损耗 ($E_{off}=2.1mJ$)
- 高短路耐量 ($>10\mu s$)
- 无铅，符合RoHS



应用领域

- 电机传动
- 伺服驱动器 等



IGBT(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_c=25^\circ C$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	
集电极电流	I_C	$T_c=25^\circ C$ $T_c=100^\circ C$	80 40	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1ms$	80	
总功率损耗	P_{tot}	$T_c=25^\circ C, T_{vj\max}=150^\circ C$	192	W
短路承受时间	t_{SC}	$V_{GE}=15V, V_{CC}=600V$ $T_j=150^\circ C$	>10	μs
工作结温	$T_{vj\ op}$		-40~150	$^\circ C$

IGBT(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0V, I_C=1mA$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15V, I_C=40A$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	- -	2.00 2.58	- -	
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=1.5mA, V_{CE}=V_{GE}$	-	6.10	-	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	-	-	3	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	400	nA
动态特性						
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=25V$	-	2820	-	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{GE}=0V$	-	169	-	
反馈电容	C_{rss}	$f=1MHz$	-	131	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=600V, I_C=40A, V_{GE}=15V$	-	187	-	nC
短路电流	$I_{C(SC)}$	$V_{GE}=15V, V_{CC}=600V$ $T_{j,start}=25^\circ\text{C}$ $T_{j,start}=150^\circ\text{C}$	- -	182 146	- -	A
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=40A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=33\Omega$	-	76	-	ns
上升时间	t_r		-	150	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	257	-	
下降时间	t_f		-	103	-	
开通损耗	E_{on}	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=40A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=33\Omega$	-	5.16	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	2.05	-	
开关损耗	E_{ts}		-	7.30	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=40A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=33\Omega$	-	66	-	ns
上升时间	t_r		-	138	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	292	-	
下降时间	t_f		-	186	-	
开通损耗	E_{on}	每个IGBT	-	5.30	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	2.80	-	
开关损耗	E_{ts}		-	8.10	-	
结到外壳热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	0.65	-	K/W

二极管(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_C=25^\circ\text{C}$	80	A
		$T_C=100^\circ\text{C}$	40	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	80	
工作结温	$T_{vj\text{op}}$		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=40\text{A}$	-	1.71	-	V
		$T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.54	-	
开关特性						
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^\circ\text{C}$	-	280	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=40\text{A}$ $-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	3.10	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		-	22.5	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^\circ\text{C}$	-	456	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=40\text{A}$ $-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	8.10	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		-	29.8	-	A
结到外壳热阻	R_{thJC}	每个二极管	-	0.90	-	K/W

IGBT(制动-斩波器) 最大额定值 (未特殊说明时, $T_C=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	
集电极电流	I_C	$T_C=25^\circ\text{C}$ $T_C=100^\circ\text{C}$	30 15	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1\text{ms}$	30	
总功率损耗	P_{tot}	$T_C=25^\circ\text{C}, T_{vj\max}=150^\circ\text{C}$	125	W
短路承受时间	t_{SC}	$V_{GE}=15\text{V}, V_{CC}=600\text{V}, T_j=150^\circ\text{C}$	>10	μs
工作结温	$T_{vj\text{op}}$		-40~150	$^\circ\text{C}$

IGBT(制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0\text{V}, I_C=1\text{mA}$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15\text{V}, I_C=15\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	- -	1.85 2.35	- -	
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=0.5\text{mA}, V_{CE}=V_{GE}$	4.70	5.80	6.70	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	-	-	2	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=20\text{V}$	-	-	400	nA
动态特性						
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=25\text{V}$	-	1120	-	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{GE}=0\text{V}$	-	91	-	
反馈电容	C_{rss}	$f=1\text{MHz}$	-	51	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=900\text{V}, I_C=15\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$	-	71	-	nC
短路电流	$I_{C(SC)}$	$V_{GE}=15\text{V}, V_{CC}=600\text{V}$ $T_{j,start}=25^\circ\text{C}$ $T_{j,start}=150^\circ\text{C}$	- -	75 50	- -	A

开关特性 (感性负载)						
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=15\text{A}$	-	14	-	ns
上升时间	t_r		-	41	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	135	-	
下降时间	t_f		-	121	-	
开通损耗	E_{on}	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$ $R_G=20\Omega$	-	0.87	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.71	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.58	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=15\text{A}$	-	13	-	ns
上升时间	t_r		-	41	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	177	-	
下降时间	t_f		-	183	-	
开通损耗	E_{on}	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$ $R_G=20\Omega$	-	0.92	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.01	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.93	-	
结到外壳热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	0.80	-	K/W

IGBT(制动-斩波器) 最大额定值 (未特殊说明时, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_c=25^\circ\text{C}$	25	A
		$T_c=100^\circ\text{C}$	15	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	30	
工作结温	$T_{vj op}$		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
正向压降	V_F	$V_{GE}=0V, I_F=15A$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	- -	2.10 1.60	- -	V
开关特性						
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^\circ\text{C}$	-	250	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600V, I_F=15A$	-	1.32	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=550A/\mu\text{s}$	-	12.79	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^\circ\text{C}$	-	361	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600V, I_F=15A$	-	3.02	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=550A/\mu\text{s}$	-	18.1	-	A
结到外壳热阻	R_{thJC}	每个二极管	-	1.60	-	K/W

整流器最大额定值 (未特殊说明时, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1600	V
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	$T_c=80^\circ\text{C}, T_j=150^\circ\text{C}$	35	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	$t_p=10\text{ms}, T_j=150^\circ\text{C} \sin 180^\circ$	420	
电流时间积分	$I^2 t$		880	A^2s
工作结温	$T_{vj op}$		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(整流器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$I_R=0.1\text{mA}$	1600	-	-	V
正向压降	V_F	$T_j=25^\circ\text{C} \quad I_F=40A$	-	1.3	-	V
		$T_j=150^\circ\text{C} \quad I_F=40A$	-	1.5	-	
反向漏电流	I_R	$T_j=25^\circ\text{C} \quad V_R=1600V$	-	10	-	μA
		$T_j=150^\circ\text{C} \quad V_R=1600V$	-	500	-	
结到外壳热阻	R_{thJC}	每个二极管	-	0.70	-	K/W

负温度系数热敏电阻

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
额定电阻值	R_{25}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	-	5	-	K Ω
R100偏差	$\Delta R/R$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, $R_{100}=481\Omega$	-5	-	5	%
耗散功率	P_{25}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	-	50	-	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298.15\text{K}))]$	-	3380	-	K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298.15\text{K}))]$	-	3440	-	K

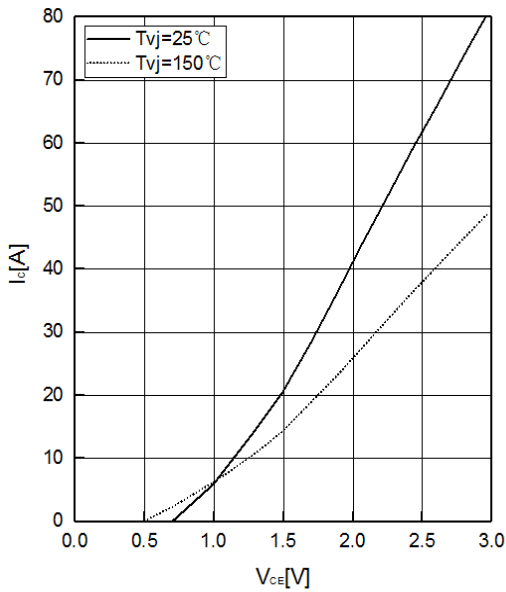
模块

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	$f = 50\text{Hz}$, 1minute	2500	-	-	V
最大结温	$T_{\text{vj max}}$		-	-	150	$^{\circ}\text{C}$
工作结温	T_j		-40	-	150	$^{\circ}\text{C}$
外壳－散热器热阻	$R_{\theta\text{CS}}$	每个模块	-	0.03	-	K/W
储存温度	T_{stg}		-40	-	125	$^{\circ}\text{C}$
模块安装扭距	M	Mounting Screw:M5	4.0	-	6.0	N·m
重量	G		-	200	-	g

输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)

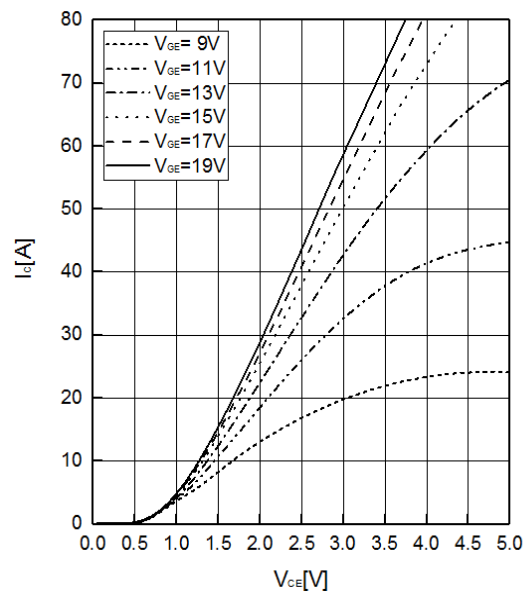
$I_c = f(V_{CE}), V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)

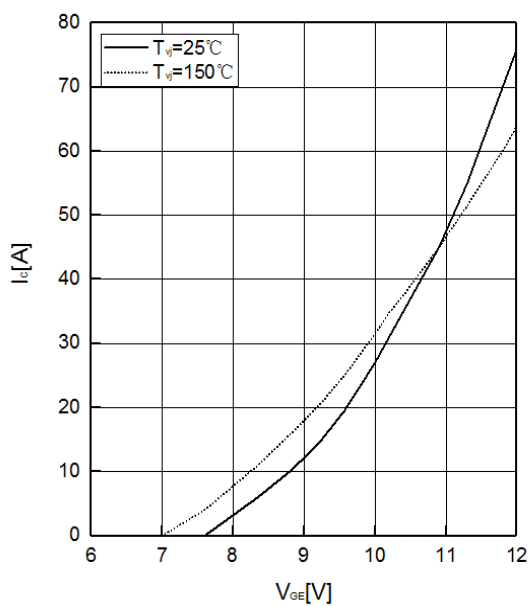
$I_c = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ\text{C}$



传输特性 IGBT, 逆变器 (典型)

transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_c = f(V_{GE}), V_{CE} = 20\text{ V}$

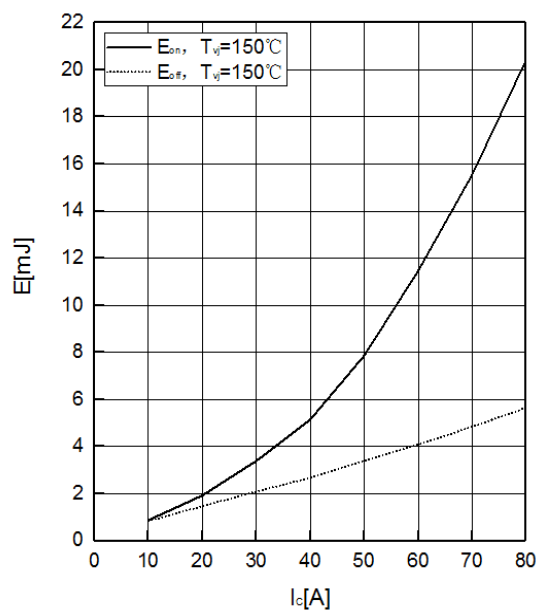


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_c), E_{off} = f(I_c)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 33\ \Omega, R_{Goff} = 33\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}$

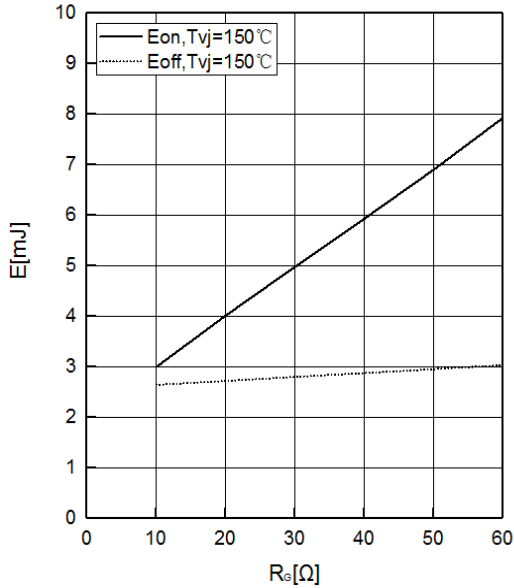


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 40\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

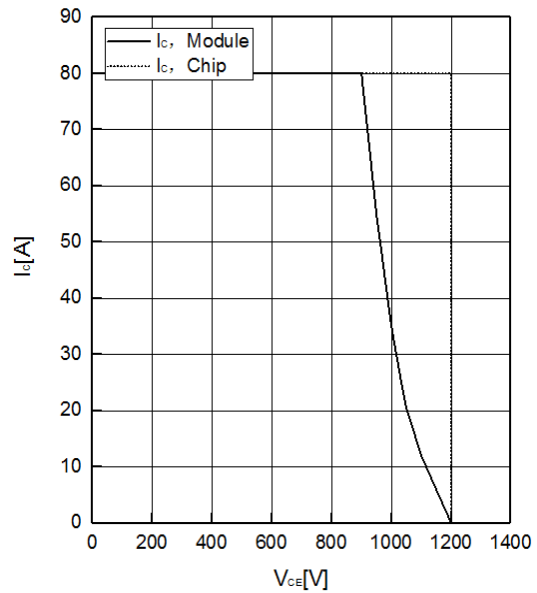


反偏安全工作区 IGBT, 逆变器 (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT, Inverter

$I_C = f(V_{CE})$

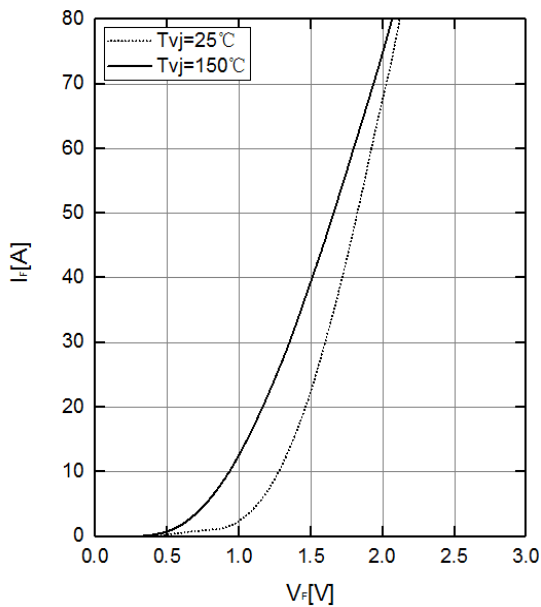
$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 33\ \Omega$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



正向偏压特性 二极管, 逆变器 (典型)

forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

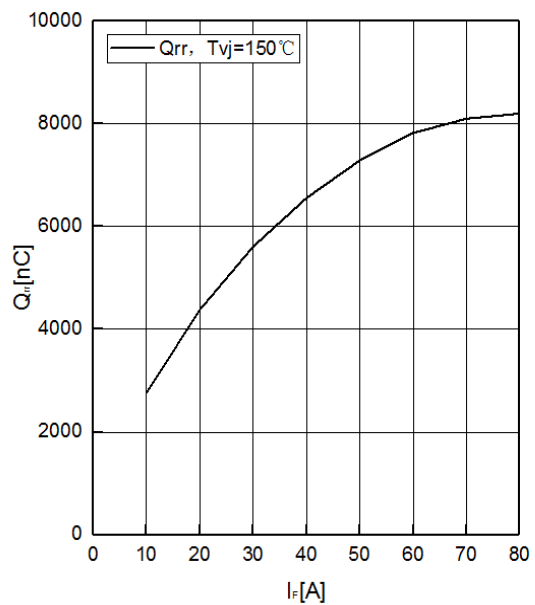
$I_F = f(V_F)$



恢复电荷 二极管, 逆变器 (典型)

recovered charge of Diode, Inverter (typical)

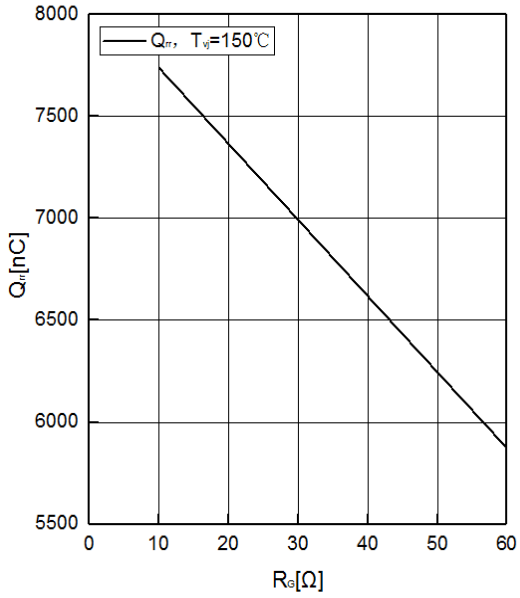
$Q_{rr} = f(I_F)$



恢复电荷 二极管,逆变器 (典型)

recovered charge of Diode, Inverter (typical)

$Q_{rr} = f(R_G), I_F=40A, V_{CE} = 600V$



负温度系数热敏电阻 温度特性

NTC temperature characteristic (typical)

$R = f(T)$

